

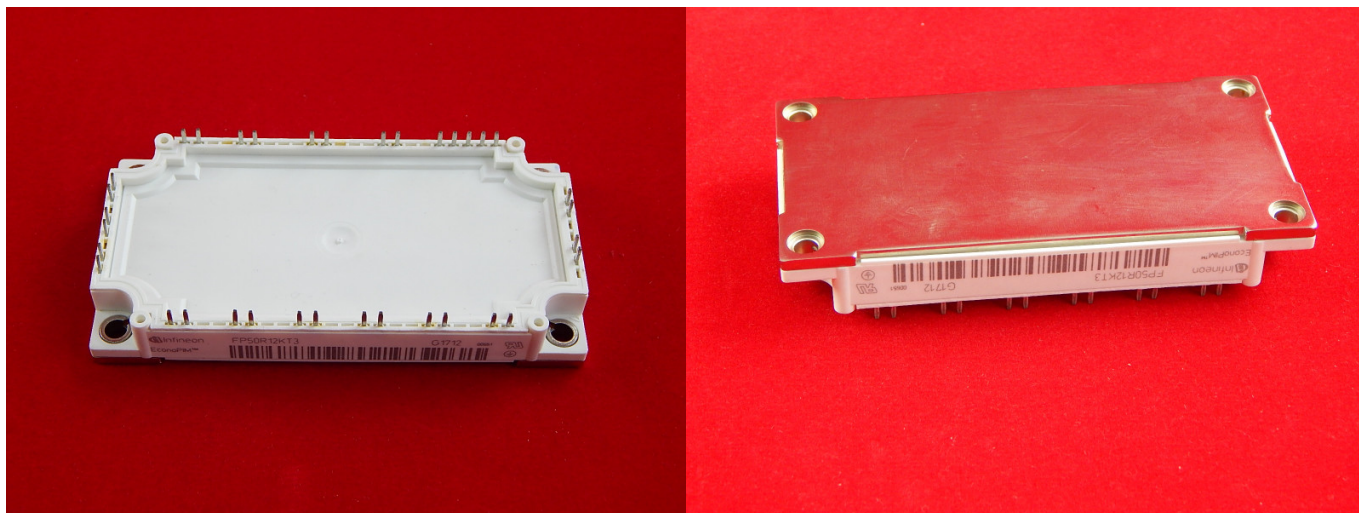
г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 13422      Цена в прайсе: 51261 тг.**

**FP50R12KT3 Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)**



Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) N-CH 1.2KV 75A

Товар по предзаказу. Срок поставки 3-5 недель

Категория продукта: Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)

Продукт: IGBT Silicon Modules

Конфигурация: Hex

Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс.: 1200 V

Непрерывный коллекторный ток при 25 C: 75 A

Минимальная рабочая температура: - 40 C

Максимальная рабочая температура: + 125 C

Высота: 17 mm

Длина: 122 mm

Ширина: 62 mm

Вид монтажа: Screw

Максимальное напряжение затвор-эмиттер: +/- 20 V

Другие названия товара №: FP50R12KT3BOSA1 SP000100445